ラジエーション・コロージョン

本間 禎 -

放射線照射を伴うとき、コロージョン現象がどのように変化するか.速度論的に、律速 段階になる過程は影響をうけるのか.平衡論的にどんな変化が可能なのか.これらの問 題をコロージョンの素過程をたどりながら概観し、さらに将来の研究指針を探ってみた.

1. ラジエーション・コロージョンとは

放射線照射のもとで金属材料の腐食現象はどのような 影響をうけるのだろうか、

放射線の種類で,量で,あるいはエネルギーで一般的 にどんな差異があるのだろうか.

このような問題を扱うのがラジエーション・コロージ ョン (radiation corrosion) とよばれる学問である.

この領域の研究の歴史はきわめて新しく,組織的な出 発は第二次大戦後といえる. もちろん,19世紀末にX線 が発見されてから後に,この放射線が物質の諸性質にど のような影響を与えるかという問題も当然とりあげられ はしたが,そのエネルギーにしても線量にしても制限さ れた範囲のなかでしかなかった.

第二次大戦を契機にして,原子核エネルギーの解放が 新しく原子力工業を生みだし,そこに従来と異なる諸性 質をもつ新しい材料を要求したとき,その要求に応える 材料(つまり熱中性子吸収断面積の大きさのほかに,一 般的に放射線照射効果を示さない安定した物理的,化学 的または機械的特性をもつもの)を開発するために放射 線の照射効果に関する知識が必要となってきた.

こうした背景の中から放射線化学が生まれ,放射線損 傷の問題が学問として研究されはじめた.

ラジエーション・コロージョンは、放射線を照射した 場合の物質の物理化学的変化を扱う点では放射線化学の なかに属する学問であるが、はじめにも述べたように、 おもに金属材料を含む固体物質が気体または液体と反応 して、界面に膜状の反応生成物をつくるいわゆる造膜反 応における照射効果を扱う点で範囲が限定されている. この場合にはつぎのような問題が起こってくる.

(1) 周囲のふんい気(気体または液体)の照射効果(2) 被腐食物質(固体)自体の照射効果

とくに(2)の場合には生成した膜状物質(酸化物のようなセラミック)が下地物質と異なる照射効果をうけ, さらに膜状物質形成ののちは反応物質がそのなかを移動 して反応する拡散反応を伴うので拡散媒質の物理的性質 によって強く影響をうける.そこでこの問題を扱うには 化学的性質についてはもちろん,物理的ときには機械的 性質の照射による影響を理解しておく必要が生ずる.

ここではラジエーション・コロージョンに関連する化 学的,物理的および機械的性質の照射効果について,わ れわれが現在どのような知識と問題をもっているかを概 観してみたい. 浅学の著者の目がおよばないで,逸脱し たりあるいは片よった問題の扱いがあることはご寛容を ねがい,この問題を考慮する読者の参考に供したい.

2. 照射効果

(1) 周囲のふんい気の照射効果

はじめに照射効果の基本的な知識をまとめてみよう.

通常放射線源としては α 線, β 線, γ 線, 陽子線, 電 子線, X線, 中性子線と多種多様で, そのエネルギーに よっても効果が異なるが, 参考として現在原子炉材料と して問題となる放射線と損傷の種類を第1表に示した.

第1表 原子炉中に存在する放射線と それによる損傷

放射線	要 点	損傷の種類
高速中性子(n _f)	質量 1 電荷 0 E 10 ⁴ eV または以上	原子の変移 イオン化
熱中性子 (n _{th})	質量 1 電荷 0 E~0.025 eV	変換 イオン化
アルフア粒子(α)	質量 4 電荷 2	変移,核反応, イオン化
分裂生成物	分裂した原子の破片	変移とイオン化 が著しい
ビ <i>ーター</i> (β)*	質量 1/1837 電荷1	小数のイオン化
ガンマ(r)	電磁波 λ=10 ⁻⁷ ~10 ⁻¹¹ cm	イオン化

* β線は原子核から出るものをいい,電子線は核外電子を 人工的に加速して得られるものをいう.

ところで周囲のふんい気の照射効果を考えることは、 つまるところ気体または液体の照射効果を問題にするこ とになるが、はじめに気体からとりあげたい.それは、 気体中では分子間の距離が液体や固体に比して離れてい て、それらと反応の様相が若干異なり、液体や固体では 直接調べることが困難な過程なども調査できるので、気 体中の反応で得た知識が液体や固体内の反応を考える基 礎になるからである.

気体は分子性化合物(単原子分子を含む)であり,各 原子が共有結合によって結ばれており,この共有結合に よって分子を形成している.

一般的にいって気体の照射効果はイオン化と励起を含

む化学的なもので、固体の場合の原子の変移(displacement)とかイオン化による結晶の格子欠陥を含む物理的 なものと区別できる.

さて分子性化合物にX線, γ 線などの光子が当たると 主としてコンプトン散乱によってイオン化が起こる². コンプトン散乱の起こる確率は入射光子のエネルギーに あまり関係せずほぼ一定である.このときたたき出され た電子は高いエネルギーをもち電子線, β 線と同じはた らきをする.分子内電子の直接励起の確率はイオン化に 比べて小さい.電子線, β 線ではイオン化のほかに分子 内電子の励起も起こる. α 線, 陽子線, 重陽子線などの 荷電粒子は電子線とほぼ同じ作用をするが, その絶対値 が電子線の場合より非常に大きい.

中性子は電荷をもたないので分子内電子の励起,イオ ン化を起こすことはない.中性子による直接効果は(1) 原子核との弾性衝突,(2)原子核との核反応(おもに(n, 反応)が考えられる.以上をまとめると,中性子の場合 ?)を除いてその外の放射線による照射効果はイオン化と 二次電子による分子内電子の励起と,こうして生じた励 起分子,イオンの反応,分解による遊離基の生成までの 一次過程およびそのあとに起こる化学反応を含む二次過 程よりなっている.いいかえれば放射線による化学反応 は光化学反応と同様イオン化励起を含む初期過程と熱反 応の二次的過程との2過程からなっている.これを図式 的に示せば,

一次過程

А	放射線	$A^{+} + e^{-}$	イオン化	
А	放射線	A*	励起	
А	放射線	$A^{+\!*}\!+\!\mathrm{e}^-$	イオン化と励起	
二次遗	司程			
A*→R1+R2(結合切断遊離基生成)				
A+	+e ⁻ →A*	(電荷中和に	よる励起)	

 $A^++B \rightarrow A+B^++E$ E: $x \neq \nu \neq$

(電荷転移 charge transfer)

A*+B→A+B* (励起化転移 excitation transfer) A++M⁻→生成系

たとえば水素を α 粒子で照射したときはつぎの反応 が起こると考えられている.

 $H_2 \xrightarrow{b}{h} \Re H_2^+ + e$

H₂ 放射線 H₂*→2H[•] H[•]: 遊離基状態 H₂++H₂→H₃++H[•] H₃++e→H[•]+H₂*

H₂*→2H•

 CO_2 は室温では α 線で実際上分解は認められないが, 固形炭酸は低温 (77°K) で徐々に分解し, つぎの反応が 起こる.

 CO_2 放射線 CO+O CO+O 放射線 C+O+O 液体では放射線の照射でできるイオンや遊離基が,どんなものであるかを調べることはなかなか困難であるが,電子スピン共鳴吸収法はこの調査の有力な方法といえよう.密度が大きいことから気体と違って,つぎのようなことが起こってくる.

- (a) 電子状態の励起した分子が他の分子にエネルギーを移してより安定な状態に移る機会が多くなる.
- (b) イオンや遊離基の再結合がひんぱんに起こる.
- (c) 分子が切断時に生ずる破片が周囲に稠密に配列 する分子に反跳され逃げだしにくくなり、いわゆる cage effect を生じ遊離基の再結合が増加する.ただ し水素原子やメチル基などの小さいものは逃れる確 率がかなり大きい.
- (d) 極性の液体では溶媒和効果のためにイオン安定 度が変化する. たとえば H_2O^+ は気体中では比較 的安定であるが水中では水和の結果分解する.

液体の例として水では

H ₂ O 放射線	$H_2O^+ + e^{-1}$
$H_2O^+ \longrightarrow$	$\rm H^+\!+\!OH$
$H_2O + e^- \longrightarrow$	$OH^- + H_2$
$H+H \longrightarrow$	H_2
$OH+OH \longrightarrow$	H_2O_2

けっきよく周囲のふんい気の照射効果は、気体にしろ 液体にしろいずれにしても、起こりうる素過程を見つけ だしコロージョンへの効果をそれぞれの場合に検討する ということになる.

(2) 被腐食物質の照射効果

この場合照射の対象となる物質は固体であり,気体と はかなり異なった照射効果が発生する.よく知られてい るように照射によって固体の物理的および機械的性質は 変化する.とくにラジェーション・コロージョンの問題 では造膜反応を扱うため多くの場合物理的,機械的性質 が関連する 被膜中の 物質拡散過程が 律速段階に なるの で,ここでは腐食進行に関係する物理的,機械的性質の 変化がどのようにしてもたらされるかについてとりあげ る.

固体中の放射線損傷はおもにつぎの3種が考えられる. (a) イオン化と電子励起

(b) 変換損傷 (transmutation damage)

(c) ハジキ出し損傷 (knock-on damage)

これらの損傷がどのような過程で発生し,どんな欠陥 を固体のなかにもたらすかをそれぞれについてみてみて みよう.

(a) イオン化と電子励起

γ線あるいは高速荷電粒子線が結晶格子を通過すると き原子の外殻電子をとり除くかあるいはより高いエネル ギー準位へ移すことによってもたらされる.粒子の種類 で変化するある限界エネルギー以上で,入射粒子のエネ

ルギーの大部分はイオン化に費される.核分裂生成物は きわめてイオン化を生じやすい.ところで非金属の電気 的性質はとくに電子の変移に感受的で,照射効果の研究 に広く用いられている.ときにはとり除かれた電子は欠 陥に捕獲され色中心 (color centeres) をつくる.半導体 では,このようにして電気伝導率が大きく変化する.

(b) 変換損傷

熱中性子と格子原子の核反応によってできた不純物原 子と格子点にはじめからあった原子の置換によってもた らされる損傷で,たとえば $B^{10}(n, \alpha)Li^7$ + He^4 で生じた 気体ヘリウムが気泡の核発生と成長を伴って 異 常 膨 張 (abnormal swelling) を起こすような損傷をいう. とき には脆性材料を破壊にいたらせることもある.

(c) ハジキ出し損傷

核分裂片、 α 粒子, 高速中性子などはそのエネルギー をイオン化を伴う非弾性衝突で失うが, 十分低いエネル ギーになると弾性衝突で失うようになる. もし格子点の 原子が弾性衝突で受けとるエネルギーが約 25 eV 以上 になるとハジキ出されて原子の変移 (displacement) が起 こる. 核分裂片は荷電をもつので衝突断面積は比較的大 きく, 短距離範囲に密集した損傷の跡をのこす. このと きハジキ出された原子は一般に十分高いエネルギーをも っているので二次, 三次の変移を起こし, 空格子点と格 子間原子を含む損傷スパイク (spike of radiation damage), をもたらす. 分裂片による効果は, その飛程が 10 μ m くらいなので原子炉のなかでは燃料物質とその近傍 に限られる. 高速中性子は衝突の確率が小さいので分散 した変移をつくりだす. その飛程から原子炉材料の大部 分が照射範囲にはいる.

固体の物理的,機械的性質の変化の多くはハジキ出し 損傷が関係する.たとえば格子間原子をつくりだすこと による膨張は密度変化となり,格子配列の破壊は硬度や 弾性率を変化させる,変移原子による転位の拘束は変形 を阻止する.セラミックでは照射損傷によってグリフィ スき裂 (Griffiths crack)が発生,伝ぱんして脆性破壊に いたることもある.熱伝導率の低下と熱スパイク (thermal spike)とよばれる³⁾, 10⁻¹¹ s 程度の短時間の融点に 近い高温状態にいたる現象が相伴い,加熱と急冷が準安 定相の導入とか拡散の過程を助ける.

以上の三種類の照射効果によって固体のなかに損傷が つくられると同時に熱的回復効果が起こるが、これらが コロージョンとどのように結ばれるのであろうか. 化学 的性質の照射効果は必ずしも一義的に扱うことができな い. なぜなら化学的性質は反応系の組合せによって変化 するからで、たとえば固一気相反応系において固相が変 化しなくても気相が変化したとき(酸素分子が原子状酸) 素あるいはオゾンに変化して)反応が進むことがある が、造膜反応では若干異なる. SiC は酸化によって硝子状 SiO₂ を表面に形成し耐酸 化性をもつ.これに照射を加えるとこの表面層が失透し て耐酸化性が低下することが知られている.しかしこの 現象は化学的性質の変化と考えるよりはむしろ表面層の 物理的性質の変化が直接の原因と思われる.けっきょ く,照射下腐食では先の三種類の基本的照射効果による 物理的,機械的性質の変化がより重要な因子であると考 えられる.

すでにのべたように被腐食物質(固体)の腐食反応は 造膜反応が一般的であるが、この場合生成被膜は多くの 場合セラミックと考えられる.一度この被膜が形成され るとその後の反応はセラミック中の格子欠陥を媒介にす る拡散過程によって律速される.この段階では、下地物 質の性質変化の影響は実際問題として二次的因子とな る.

下地物質たとえば金属の照射効果については多くの研 究と報告があるので,ここでは紙数の都合からも割愛 し,問題の主役を演ずるセラミックの照射効果について もう少し詳しく,そして具体的にながめることにする.

(3) セラミックの照射効果

(a) 格子欠陥の形成

造膜反応を律速する拡散過程は当然照射効果を示す. 直接には、格子欠陥の量の変化として導入される. この 場合照射によって、もとの格子点からハジキ出されて格 子間に変移し、そこに格子間原子として残るとともに、 もとの格子点を空席のまま保持するいわゆる空孔と格子 間原子の一対でなりたつフレンケル対 (Frenkel pair) が 中心となる. フレンケル欠陥の生成の難易とできてから の安定性は物質の結晶構造と原子間の結合様式によって 支配される. セラミックではイオン結合, たとえば UO₂ から共有結合のダイヤモンドや SiC にいたる変化がある ので問題は複雑であるが定性的に傾向を示すことはでき る. イオン結合は静電的で方向性がなく,ある程度の歪 みを許容できる.一般に,最も安定な構造は最密構造と 高い対称性をもつもので、たとえば UO2 の照射にたい する良好な安定性は、そのホタル石型最密構造にある. これに反し斜方晶型 U3O8 は低い放射線量で容易に破壊 する. 共有結合は方向性がある強い結合で、格子歪を許 容しがたいので照射感応性は共有性の増加に比例して増 加する.格子欠陥の生成量については現在十分な直接の 情報が得られていないが、二三間接的資料を指摘してお きたい.

セラミックでは当然格子欠陥の有効電荷が考えられる ので拡散に伴う電気伝導が期待されるが、この場合必ず しも Einstein の関係が成立せず、定量的討論にはまだ 多くの問題が残されている⁴⁾. ところでフレンケル欠陥 は容易に理解できるように、密度変化と拡散に伴う質量 移動をもたらす.発生した欠陥の固着、消滅などの複雑

第15巻第6号

第2表 照射によるセラミックの密度変化6,7)

物	質	照射量 nvt	密 度 g/cm	密度変化 %	結晶構造イ	オン結合度*
Al ₂ O ₃	単結晶	${}^{6 imes 10^{19}}_{6 imes 10^{20}}$	3,983	0.3 1.0	六方 コランダム	0.62
Al ₂ O ₃	焼 結	${}^{3 imes 10^{19}}_{4 imes 10^{20}}$	3, 559	-0.17 + 7.0		
BeO		6×10^{19} 1.5×10 ²⁰	2.84	-0.03 -0.04	ウルツァイト型	0.62
MgO	単結晶	5×10^{19} 1. 2 × 10 ²¹	(3.65)	-0.1 -0.2	立方 Nacl 型	0.71
SiO2	溶融法	$7 \times 10^{19} \\ 4 \times 10^{20}$	2,204	$^{+2.3}_{+1.2}$	六方	0.50
ZrO_2		5×10^{10} 3×10^{20}	(5.7)	-6.7 -7.1	単斜	0.60
${\rm TiO}_2$		${}^{6 imes 10^{19}}_{8 imes 10^{20}}$	4.01	-0.5 -0.75	正方	0.60
MgO・ スピネ	A12O3 ル	${}^{7\times10^{\tiny 19}}_{4\times10^{\tiny 20}}$	3.60	0.00 0.00	立方	

* イオン性の量=1-exp $(-c(x_A - x_B)^2)$: $|x_A - x_B|$ =電気陰性度の差,

(L. ポーリング, 化学結合論)

な過程も共存しうるが、欠陥の発生についてかなり直接 的情報を提供することも期待される. 第2表は照射によ る密度変化を結晶構造、イオン結合の割合とともに参考 に示した.

(b) 熱伝導度⁵⁾

照射効果としてセラミックのなかにできた熱スパイク は局所的な高温部をつくりだす.ときには融点近くに達 するこの部分はきわめて不安定で,相変態,格子不整に 導くとともに熱応力によってセラミックに機械的損傷を 与える.コロージョンの立場からは安定な保護被膜の形 成が望まれるので,セラミックの熱伝導率と熱ショック への抵抗が問題になる.ラジェーション・コロージョン に関係する物理的性質の一つとして熱伝導度をここで, 機械的性質の一つとして熱応力抵抗 (thermal stress resistance) をつぎにとりあげる.

固体中で熱は格子振動と電子の移動によって伝わる⁸⁾.

 $K_{T} = K_{L} + K_{e}$

ここで K_L は格子が, K_e は電子が関係する熱伝導率 で K_T はその合計したものを示す. セラミックでは高温 においてさえも自由電子の数が少ないので K_e が一般に 小さい.

電磁振動が光子と結びつけられるように格子振動は音 子と結ばれつぎのような関係をもつ⁹⁾.

 $K_L = c \nu l/3$

ここで c は物質の比熱, v は音子の平均速度で近似的に 音速に等しい.そして l は音子の平均自由行程を示す.

デバイ温度(たとえば SiC 230°, BeO 750°, MgO 600°, UO₂ 600°, ThO₂ 200°C)以上で $c \ge \nu$ は近似的 に一定になり K_{L} はほぼlに比例するようになる. もし 格子振動が完全に調和的であるとlは無限大になり K_{L} が無限大となる. 実在結晶ではlはさまざまな過程で減 少する. いま熱伝導率の逆数を熱抵抗 W_{L} と規定する と, 153

 $W_L = W_u + W_i + W_{im} + W_{vs} + W_{mb}$ … と表現できる¹⁰⁾. ここに W_u は非調和熱振 動, W_i は同位元素, W_{im} 不純物, W_{vs} 空 格子点, W_{mb} モザイク境界の効果を意味す る. W_u は結晶に固有でデバイ温度以上でも 温度とともに変化する. そのほかの効果は温 度依存が無視できるのでつぎのようになる.

 $W_L = aT + b$ $T : \mathbb{Z}$

 K_L , c, ν の測定値から多くのセラミック では l の値が室温で 30~100 Å, 1200°C で 5~10 Å の値がえられる¹¹⁾. 理論的に K_L が 結晶格子の対称性に依存することから, 同じ 質量をもつ陽イオンと陰イオンが同数からな る簡単な構造の物質が高い熱伝導度をもつこ とが期待される.

また同位元素の存在は W_i の増加として K_L を減少 させる. BeO, MgO, SiC が高い熱伝導度をもつこと, および対称性がより高く原子量がより近い値にもかかわ らず MgO が BeO より熱伝導率が低い値をとることも 理解できる. この場合 Be は完全に Be⁹ からなり Mg は三種類の同位元素を含む. ある種のセラミック, たと えば Al₂O₃ や TiO₂, MgO では高温で(多結晶で~1400 °C) 熱伝導率が極小値をとることがある(第1図). 高



第1図 熱伝導率の温度による変化¹²⁾

温で T^3 で変化することから熱輻射による熱移動が期待 される.単結晶ではこの極小位置が低温側 (\sim 600°C) に 移動する. UO₂ 多結晶で照射により 1400°C 以上に観察 された例もある.

これら原子的機構のほかにさらに巨視的因子が熱伝導 に関与する.その一つに気孔度 (porosity) がある.この 効果は Loeb の経験式で記述できる¹³⁾.

 $K = K_0(1 - P)$

 K_0 は気孔のない稠密なときの熱伝導率, P は気孔の存 在度を示す. このほか異種相の存在効果があり, この場 合は Euken の式で扱える¹⁴⁾.

$$K_{r} = K_{l} \left[\frac{1 - (1 - AK_{2}/K_{1}) V_{2}}{1 + (A - 1) V_{2}} \right]$$

 $A\!=\!3K_{\rm 1}/(2K_{\rm 1}\!+\!K_{\rm 2})$

体積比 V_2 だけ存在する熱伝導率 K_2 の異種物質を含 む, K_1 の伝導率をもつ物体中の全熱伝導率 K_p を示す. そこで, 照射効果が熱伝導率にどのように影響するか をみてみよう.

一般的にいえば、照射による格子欠陥の生成は W_{u} , W_{vs} を増加させ、核反応による同位元素および異種原 子の生成が W_i , W_{im} を増加させるので、 W_L の増加 すなわち K_L の減少となる. このほか変換損傷による気 孔度の増加や、再結晶の誘発による結晶寸法の変化が影 響を示す(音子の平均自由行程が結晶粒径より十分小さ いときには結晶粒界による抵抗は著しく減少する)¹².



照射によって熱伝導 率が変化するもよう を第2図と第3表に 示した.

表から示されるよ うに照射によって伝 導率が著しく低下す る.しかし個々の場 合については必ずし も簡単な挙動を示さ ず,また測定資料も 少ない.とくに高温 い.

第3表 照射による熱伝導率変化6)

物質	照射量 nvt	熱伝導率 104 Cal/°C cm sec	熱伝導率変化 % (30°C)
Al₂O₃ 単結晶	${}^{6 imes 10^{19}}_{6 imes 10^{20}}$	600 ± 200	50 66
Al ₂ O ₃ 焼 結	${}^{3 imes 10^{19}}_{4 imes 10^{20}}$	$400\!\pm\!100$	-42 -77
BeO	7×10^{19}	(4800)	
ZrO ₂	5×10^{19}	(47)	-81
TiO ₂	${}^{6 imes 10^{{\scriptscriptstyle 19}}}_{3 imes 10^{{\scriptscriptstyle 20}}}$	165 ± 20	33 61
MgO•Al₂O₃	$7 \times 10^{19} \\ 4 \times 10^{20}$	250 ± 50	-48 -48

しかし高温では生じた欠陥が一部熱的回復をすることか ら、必ずしも不利な条件下とは断定できない.

(c) 熱応力抵抗^{15),16)}

照射効果として、金属の場合のような機械的性質の変 化が考えられる.熱伝導度の変化とともに、ヤング率や ポアソン比が変化すると熱応力抵抗が変化してときには セラミックの機械的破壊を生ずることがある.熱スパイ クと、とくに関連するこの熱応力抵抗についてその照射 効果をみるまえに、二三の基本的事項から説明しよう.

急冷によって物質内に t, t'の温度差が生じたとき, 発生する応力 σ はつぎのようになる. $\sigma = E\alpha(t-t')/(1-\mu)$

ここに E はヤング率, α は線膨張係数, μ はポアソン 比, さらに S を破壊強度とすると破壊をもたらす温度 差.

 $t-t'=S(1-\mu)/E\alpha$

が与えられる. $S(1-\mu)/E\alpha = R$ として熱応力抵抗 Rを 定義する. セラミックでは μ は 0.2~0.35 の値をとり $(1-\mu)$ がほぼ一定と近似される.

R の値は E, α , μ の函数で与えられるので, これら の値の照射による変化で当然変化する. R の照射によ る変化について第4表に示した. 表にはヤング率の変化 も参考に示してある. また第3図には, 熱伝導率の変化 による破断温度差 t-t'が二三のセラミックについて示



′熱 伝 導 率・log K

第 3 図¹⁶⁾

第4表 照射による熱応力抵抗と ヤング率の変化^{6),15)}

物	質	照射量 nvt	熱応力抵抗 照射前	Cal/cm•sec 照射後	ヤング率変化 % (25°C)
BeO		7×1019	27.6	18.6	
Al ₂ O ₃		4×10^{20}	7.5	2.4	<-10
MgO•	Al ₂ O ₃	$4 imes 10^{20}$	2.66	1.34	
UO₂(1	100°C)		1.82	0.73	
UO₂(7	700°C)	—	0.86	0.86	
SiO₂		1.6×10^{2}	o <u> </u>		< -5
ZrO₂		1.6×10^{20})		<-10
TiO2		6×101			<- 5

してある.熱応力抵抗は照射中にかなり低下することが 予想できる.ヤング率も照射中に減小し一般に脆性にな る傾向が認められる.しかし高温では熱的回復によって 実質的に照射効果が無視できる可能性も期待できる.

以上セラミックの物理的,機械的性質の照射効果をと おしてラジェーション・コロージョンにおいて問題とな る因子を明確にしてきたが,実際の場合に,腐食の過程 は照射効果でどの程度変化し,起こっている現象が以上 の因子でどのくらい説明できるのかを比較検討してみよ う.



3. 実験結果

(1) ニオビウムの酸化

ヤングらは 400°C 付近におけるニオビウムの酸化への 中性子照射 (~10¹² nv) の影響を研究した. かれらは照 射前の酸化曲線 (第4図) から, 10 Å/hr の酸化速度で 約 5000 Å の酸化被膜が成長するとき 各中性子が 10 格 子欠陥/cc をつくりだすとして 10¹² nv ではおよそ 2× 10¹¹ 格子欠陥/hr・cm² の生成を想定した. (ジルコニウム と同様にニオビウムもいわゆるブレイク・アウェイ現象 が起こる. 後者の場合, そのときの酸化被膜の厚さは約 5000 Å になる).

しかし酸化速度から陽イオンおよび陰イオン欠陥数と して ~10¹⁵/hr·cm² が要求され、これはすなわち 10¹⁵~ 10¹⁶ nv に相当する照射量で、いいかえれば 10¹⁶ 以上の 照射量ではじめて酸化速度が影響をうける程度に格子欠 陥がつくられることを示す. 同様に、局所的格子不整部 分の発生の数について評価した結果、酸化速度にたいし て検出できる程度に影響を与えるには 10¹² nv 以上の照 射を必要とするという結論をえた. これを実験的に検証 するために ORNL 黒鉛型原子炉中で照射しながら ~ 400°C で 1~6 hr 酸化を行なった. 電子顕微鏡観察の 結果,照射した試料もしない試料もともに ~10⁷/cm² の 気孔が観察され、ブレイク・アウェイ発生の時期は影響 をうけずに、その際のき裂の核形成の程度も同じであっ た. このことからニオビウムの酸化では 10¹² nv 程度の 照射で酸化速度に影響を与えないことが判明した.

(2) ジルコニウムの酸化18)

Yee らはジルコニウムについて酸化へおよぼす照射効 果を観察した.この場合,照射量は ~10¹²/cm・s で,さ らに核分裂生成物を 6×10⁸/cm²・s 含む照射も行なった. 250°C 1気圧の純酸素中酸化は,核分裂生成物を伴う場 合酸化被膜が微細結晶粒で相変態も起こしていた.そし て酸化速度は中性子照射のみの場合よりやや大きい.し かし照射効果の機構は十分には解明できていない.

(3) アルミニウムの腐食¹⁹⁾

Shiells らは原子炉で照射実験に使用していたアルミ ニウムカプセルが長期間使用後に著しい腐食を示したこ とを報告している. この場合は中性子 ~1.3×10²² nvt の照射量で温度は \sim 60°C, 冷却用の循環空気が通るア ルミニウムパイプの内部がはげしく腐食したもので, 生 成物は Al_2O_{a} ・ $3H_2O$ であることが判明した. 原因とし て, 照射による直接効果はほかの金属 (Fe, Ni, Pb, Zn, Cu および Co) が腐食していないことから期待できず, 内部循環空気の照射効果による化学的変化によるものと 推定された. すなわち空気中の窒素が亜硝酸になり, 水 分とともに硝酸となって腐食をもたらすと考えた.

$$H_2O$$

 $Al \rightarrow Al(NO_3)_39H_2O \rightarrow Al_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 \cdot 3H_2O_3$

しかし,ほかにもいくつかの腐食過程が可能で結論は えられていないが,堆積効果や過熱効果はこの場合期待 できない.また電気化学的腐食でも説明できない.むし ろ周囲のふんい気の照射効果が直接の原因と考えること がより合理的であるとしている.

以上の実験結果の例にも示されているように, ラジェ ーション・コロージョンの現象は現在かなり定性的説明 が可能な半面あいまいに残された問題をかかえている.

このことは,一つには実験的困難さに原因があるが, それとともにこの現象が複雑な過程を同時に含んでいる ことにも由来している.

現在運転している原子炉の場合 (~10¹³ nv) 照射量が 10²² nvt に達するには数年を要し,そのまえに材料を交 換しているのが現状で,数年後の腐食状態を予測できる 段階にはないようである.

4. 今後の課題

ラジエーション・コロージョンの問題を解くためには 二つの課題が考えられる.その一つは、コロージョンの 現象自体をもっと明確にすることである.たとえば、拡 散の短絡回路として転位のような格子欠陥構造を考慮し たり²⁰¹針状晶発生のような局所的結晶成長と酸化被膜の なかの下部構造を関連させて酸化機構を考える^{21,221}試み が最近行なわれているがまだ多くの問題も残されてい る.腐食の問題は防食の研究が重視されすぎたためにと りのこされたきらいがあり、学問として体系づけられる ことがこれからの課題である.

もう一つは基礎的資料の充実で,たとえばセラミック の高温物性および照射下の物性変化に関する情報はきわ めて少ないのが現状で,このような知識はコロージョン の問題だけにとどまらず,宇宙工学における新材料の開 発とも結びついた課題である.セラミックの物理的・化 学的・機械的性質の照射効果の資料を系統的にそろえる ことはいま要求されている具体的課題の一つである.

最後に,発表の機会を与えて下さった本所一色貞文教 授,本学工学部三島良績教授,および電源開発KK川島信 夫氏に衷心より感謝する. (1963 年 4 月 1 日受理)

献

- 文 1) J. Howie. Nuclear Engg. 7299 (1961)
- 2) 放射化学ハンドブック, 朝倉書店 259. (1962)
- 3) G. J. Dienes and G. H. Vineyard, Radiation Effects in Solids, Interscience Publishers, New York and London
- 4) 物性物理学講座 10, "界面現象·格子欠陥", 共立出版 213.
- 5) G. Arthur, Nuclear Engg. 4 138 (1961)
- 6) J.H. Crawford and M.C. Wittels, 2nd Int. A/Conf. 5/P 679 (1958).
- 7) E.J.P. Clarke, Special Ceramics, Symposium at Brit. Cer. Res. Assn (Heywood and Co., 1960)
- 8) J.M. Ziman, "Electrons and Phonons", Oxford University Press (1960)
- 9) R. Peierls, Ann. Phys., 5, 3 (1929)
- 10) P.G. Klemens, "The Thermal Conductivity of Dielectric Solid at Low Temperatures". Proc. Roy. Soc., 208 (1951)
- 11) W.D. Kingery, J. Amer. Cer. Soc., 38, 7 (1955)
- 12) F.R. Charvat and W.D. Kinger, J. Amer. Cer. Soc.,

40, 9, (1957)

- 13) A.L. Loeb., J. Amer. Cer. Soc., 37, 2 (1954)
- 14) A. Euken, Forsch. Gegiete Ingenieur w. 3 353. (1932)
- J.L. Evans, Nuclear Engg., 8 339. (1961) 15)
- 16) W.D. Kingery, J. Amer. Cer. Soc., 38, 1 (1955).
- 17) J.V. Cathcart and F.W. Young, JR., Corrosion, 17 77 (1961)
- 18) W.C. Yee et al., J. Electrochem. Soc., 109, 3 (1962)
- 19) N.P. Shiells et al., Nucleonics, 19, 9 (1961).
- 個々の材料に関する研究報告は上記のほかつぎの定期刊行物 からえられる.

Nuclear Power, Nuclear Science and Engg. Reactor Core Materials.

- 20) W.W. Smeltzer, Abstract No. 116, The Electrochem. Soc., Pittsburgh Meeting (1963)
- 21) E.A. Gulbransen et al., Abstract No. 114, ibid.
- 一色,本間,山沢,第9回応物学会予稿集 p.157,生産 22) 研究, 14 卷 6 号 (1962)

次 昘 予 告 (7 月 号)

観 測 ロ ケット 特 集

			=		
口絵	機体,電気,観測,計測,光学系				
持集	1963年における観測ロケットの計画	糸	Л	英	夫
	計装と観測	高	木		昇
	新実験場設置について	糸	川	英	夫
	IQSY とロケット観測	前	Ħ	兤	-
	COSPAR と日本のロケット観測	畑	中	武	夫
	カッパ8L型について	糸	Щ	英	夫
	カッパ9M型について	糸	Л	英	夫
	カッパ8型8号機および9号機に	玉	木	章	夫
	ついて	斎	藤	成	文
	カッパ8型10号機について	野木民t	也, 采	条大さ	鄧
	カッパ8型11号機について	斎藤成こ	Ż , <u>P</u>	医木茸	ī夫
	カッパ8L型1号機について	森大吉印	\$\$, ∰	予村日	民也
	カッパ9L型2号機について	森	7	ちち	郎
	カッパ9M型1号機について	玉木章ラ	失, 斎	新藤成	文
	カッパ8L型, 9M型の空力特性	玉木章ラ	ŧ, 3	E石	智
	カッパ8L・8・9L・9M型の性	秋葉.	広済	t.5	L坂
	能計算		,=-10	,	
	カッパ8L型,9M型の構造強度	森	7	と吉	郎
	小型ロケットについて	玉オ	庆,	兼, 荏	山
	ラムダ735型エンジンの開発	秋	葉釒	€二	郎
	溶接ロケットチャンバの開発	安	藤	良	夫
	ラムダ地上試験用推力計 大井	•, 吉山,	小倉	了, 民	汞
	ディジタル計算機による性能計算	渡	辺	1. 10-	膀
	テレメータ达信機	大开,	備ナ	⊦, 相	谷
	高感度受信機(ての2)	尚	簡	健	
	後調記録司	入 	开, 下	局	廾 湯
	フレクーク用ログッドノンノノ カッパ8刑8号捲とね11号機にいたス	д ¹¹¹	Γ,	心日	īų.
	間におけるテレメータ実験について	゜ テレノ	- 3	研究	班
	4 mø レーダ装置	野村,	樫本	;,渡	部
	レーダ用機上アンテナと飛しょう運動	め _レ -	- ダ	研究	斑
	によるレベル変動について		- <i>1</i> 1°	TH 25	a telte
	SO 計画と SO-150 ロケットについて	· #45	- 2 - ±1	可元	4元
	加速度計な上び計測結果	· ====================================	 	ы Т	~13
	温度計・歪計・横加速度計	合	況.	和	渡
	817	, 吉山、 5	ī井.	能重	(谷
	発音弾発光検出器	吉山, 参	今派		·口 1波
		,			

比色計について	吉山, 広沢, 松島
開頭装置について	板橋,中村,吉山
ラムダ型エンジン(735-14, 735-24, 735-38)の地上試験について 高速飛 しょう体光学的追跡に関する研究第37報	植村,田中,金沢 喜久里,岡喜
カッパ 8 型ロケット(7, 8, 9, 10, 11号機)の光学的追跡について (同上第 38 報)	植村,田中金沢,黒河
カッパ9L型2号機、8L型1号機、 9M型1号機の光学的追跡について (同上第 39 報)	植村,伊藤,田中 山本,金沢
小型モデルロケットの光学的追跡に ついて(同上第 40 報)	植 村, 田 中 金 沢, 北 原
18 m¢ トラッキングテレメータアン テナ支塔の設計	丸安隆和,中村英夫
電離層直接観測器とそれによる観測結	果平 尾 邦 雄
カッパ8型11号機の宇宙線測定	宇宙線観測班
カッパ8型11号機によるケットの 姿勢測定	加藤, 青山 清水, 飯塚
ロケットによる大気光層の高さの 測定	古畑, 中村正年 中村強,中村総二
上層における気温・風の観測結果	前田, 竹屋, 松本 奥本, 大家, 建部
カッパ8型11号機による電離層中の 低周波電波伝播ならびに雑音観測	前田,木村,高倉
電離層プローブの風洞実験	土手, 一 宫,玉木
鹿児島宇宙空間観測所の起工式と 鹿児島県内之浦町両協力会の成立	下村 潤 二 朗
KT計画について	玉木,渡理
鹿児島宇宙空間観測所建設工事概要	丸安, 中村, 津田
設計概要	池辺 陽
新実験場地上設備について	斎藤,吉山,高中
ロケットの輸送について	吉山、巌
LMテストスタンド	秋葉,吉山
欧米の宇宙科学技術の現状(その2)	高木 昇
SEデータセンター報告	広沢, 山脇, 佐伯
絵務班の記録	渡 理 竜 춚